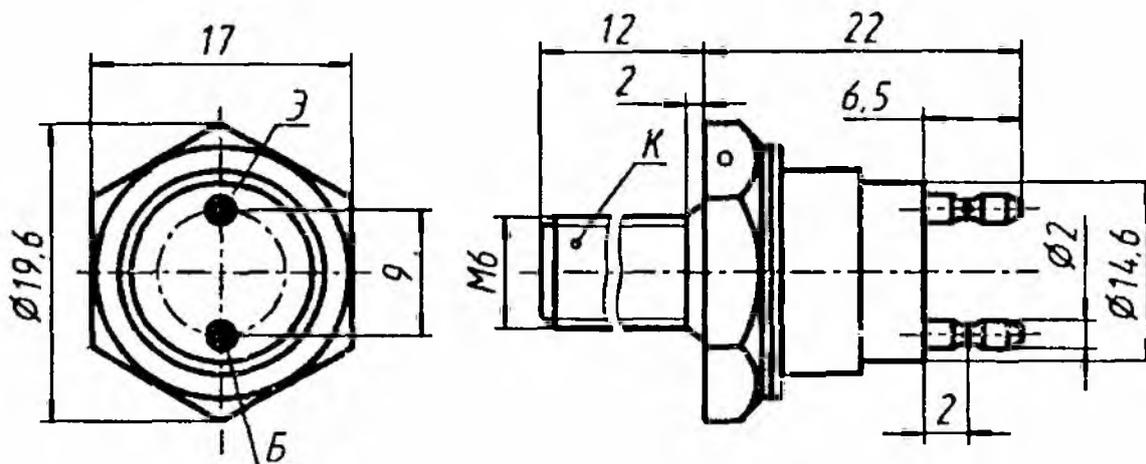


2Т926А, КТ926А, КТ926Б

Транзисторы кремниевые мезопланарные структуры *n-p-n* импульсные. Предназначены для применения в импульсных модуляторах. Корпус металлокерамический с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 20 г.

2Т926А, КТ926(А,Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при $T_K = +25^\circ\text{C}$:

$U_{KЭ} = 7\text{ В}, I_K = 15\text{ А}$ для 2Т926А 12...60

$U_{KЭ} = 7\text{ В}, I_K = 15\text{ А}$ для КТ926А 10...60

$U_{KЭ} = 5\text{ В}, I_K = 5\text{ А}$ для КТ926Б 10...60

при $T_K = T_{K, \text{МАКС}}, U_{KЭ} = 5\text{ В}, I_K = 5\text{ А}$

для КТ926А, КТ926Б, не более 200

при $T_K = T_{K, \text{МИН}}$.

$U_{KЭ} = 7\text{ В}, I_K = 15\text{ А}$ для 2Т926А 5...60

$U_{KЭ} = 7\text{ В}, I_K = 15\text{ А}$ для КТ926А 8...60

$U_{KЭ} = 5\text{ В}, I_K = 7\text{ А}$ для КТ926Б 8...60

Отношение статического коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $T_K = +125^\circ\text{C}$ к статическому коэффициенту передачи тока при $T_K = +25^\circ\text{C}, U_{KЭ} = 7\text{ В}, I_K = 15\text{ А}$ для 2Т926А, не более 3

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{KЭ} = 10\text{ В}, I_K = 1\text{ А}, f = 30\text{ МГц}$, не менее 1,7

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:	
при $I_K = 15 \text{ А}$, $I_B = 3 \text{ А}$ для 2Т926А, КТ926А, не более	2,5 В
при $I_K = 15 \text{ А}$, $I_B = 2 \text{ А}$ для 2Т926А	0,4*...0,6*...1 В
при $I_K = 10 \text{ А}$, $I_B = 1,5 \text{ А}$ для КТ926Б	0,5*...2,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер, не более:	
при $I_K = 15 \text{ А}$, $I_B = 1,5 \text{ А}$ для 2Т926А, КТ926А	2,5 В
при $I_K = 10 \text{ А}$, $I_B = 1,5 \text{ А}$ для КТ926Б	2,5 В
Обратный ток коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$:	
при $T_K = T_{K, \text{мин}} \dots +25 \text{ }^\circ\text{С}$, $U_{КЭ} = 150 \text{ В}$	0,1*...25 мА
при $T_K = T_{K, \text{макс}}$, $U_{КЭ} = 120 \text{ В}$	0,2*...80 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5 \text{ В}$, не более	300 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $T_n \leq 100 \text{ }^\circ\text{С}$, $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$	150 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер при $t_n \leq 0,5 \text{ мс}$, $Q \geq 50$, $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$	200 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	15 А
Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 0,5 \text{ мс}$, $Q \geq 50$	25 А
Постоянный ток базы	7 А
Импульсный ток базы при $t_n \leq 0,5 \text{ мс}$, $Q \geq 50$	12 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ² при $T_K = T_{K, \text{мин}} \dots +50 \text{ }^\circ\text{С}$	50 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность кол- лектора 2Т926А при $t_n \leq 0,5 \text{ мс}$, $Q \geq 50$, $T_K = +25 \dots +80 \text{ }^\circ\text{С}$	450 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус при $U_{КЭ} \leq 10 \text{ В}$, $I_K \leq 5 \text{ А}$	2 $^\circ\text{С/Вт}$
Температура р-п перехода	+150 $^\circ\text{С}$
Температура корпуса	+125 $^\circ\text{С}$

¹ При $T_n = +100 \dots 150 \text{ }^\circ\text{С}$ $U_{КЭ, \text{макс}}$ уменьшается линейно на 10% на каждые 10 $^\circ\text{С}$.

² При $T_K > +50 \text{ }^\circ\text{С}$

$$P_{K, \text{макс}} = (T_n - T_K) / R_{T(n-K)}, \text{ Вт},$$

где $R_{T(n-K)}$ определяется из области максимальных режимов например, при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $I_K = 5 \text{ А}$ $R_{T(n-K)} = 2 \text{ }^\circ\text{С/Вт}$.

Температура окружающей среды:

2Т926А	-60... $T_K =$ = +125 °С
КТ926А, КТ926Б	-45... $T_K =$ = +100 °С

При конструировании аппаратуры следует учитывать возможность самовозбуждения транзисторов за счет паразитных связей. Крепление транзисторов к панели необходимо осуществлять с помощью гайки. Осевое усилие на винт должно быть не более 120 кг. Допускается распайка транзисторов паяльником с температурой +275 °С в течение 3 с не ближе 2 мм от корпуса.